

	<p>SIR638DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR638DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter: 1.SIR638DP-T1-GE3.pdf 2.SIR638DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 286 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR638DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	286 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.88 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR638DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	204nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 100A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SIR638DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR638DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR638DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR638DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR632DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 29A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR638ADP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SIR640ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR640ADP IOR IOR QFN8</p>
 <p>SIR638DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 100A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR638DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR638ADP-T1-GE3 VISHAY SIR638ADP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIR638ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A POWERPAKSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR638DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR638DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR638DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR638DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR638DP-T1-GE3
SIR638DP-T1-GE3 Electronic	SIR638DP-T1-GE3-Komponenten	SIR638DP-T1-GE3-Verteiler	SIR638DP-T1-GE3-Bild	SIR638DP-T1-GE3-Teil
SIR638DP-T1-GE3 Preis	SIR638DP-T1-GE3 Hersteller	SIR638DP-T1-GE3 Bild	SIR638DP-T1-GE3 Aktie	SIR638DP-T1-GE3 Inventar
SIR638DP-T1-GE3 Neu	SIR638DP-T1-GE3 Original	SIR638DP-T1-GE3 garantiert	SIR638DP-T1-GE3 RFQ	SIR638DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited